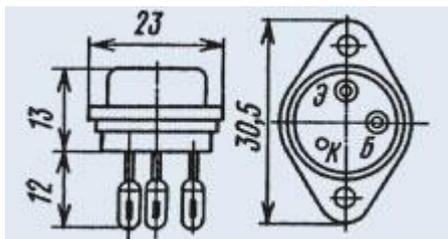


## П217А



### ▼ Основные технические параметры П217А:

#### П217А

Транзисторы П217А германиевые сплавные структуры р-п-р универсальные.

Предназначены для применения в переключающих устройствах, выходных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях постоянного напряжения.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами.

Тип прибора указан на корпусе.

Масса транзистора не более 12,5 г, крепежного фланца не более 4,5 г.

Основные технические характеристики транзистора П217А:

- Структура транзистора: р-п-р
- $P_{к\text{т max}}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 30 Вт;
- $f_{h21э}$  - Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: не менее 0,2 МГц;
- $U_{кбо\text{ проб}}$  - Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 60 В;
- $U_{эбо\text{ проб}}$  - Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 15 В;
- $I_{к\text{ max}}$  - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 7,5 А;
- $I_{кбо}$  - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 0,5 мА;
- $h_{21э}$  - Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером: 20... 60;
- $R_{кэ\text{ нас}}$  - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,5 Ом